

25Gbps InGaAs APD Chip $\phi 16\mu\text{m}$



产品描述

InGaAs 雪崩光电二极管 (APD) 芯片

产品特点

数据速率高达 25Gbps; $\phi 16\mu\text{m}$ 有效面积; 低 VBR 温度系数; 高响应度; 顶照式平面结构

应用领域

100GBASE ER4 | 25G-PON | 长距离光纤网络

核心参数

无

无

详细参数

规格 (Tc=25°C, 单颗裸芯片)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
响应范围	λ	900		1650	nm	
击穿电压	Vbr	20		30	V	I _d =10uA
VBR 温度系数			0.025		V/°C	
响应	R		8		A/W	V _R =Vbr-2V
暗电流	I _d			200	nA	V _R =Vbr-2V
电容	C		0.08	0.10	pF	V _R =Vbr-1V;f=1MHz
带宽	Bw		18		GHz	3dB down,RL=50Ω
有效区直径	D		16		um	
芯片尺寸			320*230*150		um	L*W*H